

Omron E3ZM-B66T

Технические характеристики

Цена: по запросу

Датчик фотоэлектрический для прозрачных объектов, отражение от рефлектора, металлический корпус, IP69K, 500mm, M8 разъем, NPN Output, Reflector not included

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3ZM-B66T вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (57)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	1
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Материал оптической поверхности	Пластик
Тип подключения	Коннектор M8
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 0
Материал корпуса	Металл
Степень защиты (IP)	IP67
Класс защиты лазера	Нет (без)
Тип переключающего (коммутационного) выхода	NPN
Способ настройки	Ручная настройка
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Программируемый/конфигурируемый
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Поляризованный красный свет
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Стандартная конструкция
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С временными функциями	нет
С блокировкой перезапуска	нет

С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
С другим аналог. выходом	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1.000
Ширина датчика	10.8 мм
Макс. выход. ток	100 мА
Время срабатывания	1 мс
Макс. дистанция переключения	500 мм
Высота датчика	32.2 мм
Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Мин. расстояние отражения	100 мм
Частота коммутируем. тока	1000 Гц
Номин. расстояние срабатывания	500 мм
Длина волны датчика	650 нм
Длина датчика	21 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	10...30 В
Температура эксплуатации	-25...55 °C